

## C-2

### 비대칭적인 적층주기를 갖는 BaTiO<sub>3</sub>/SrTiO<sub>3</sub> 인공격자의 격자변형과 비선형유전특성 (Lattice distortion and non-linear dielectric properties of BaTiO<sub>3</sub>/SrTiO<sub>3</sub> artificial lattices with asymmetric stacking sequence)

성균관대학교 재료공학과 김주호, 이재찬  
성균관대학교 물리학과 김이준, 정동근  
성균관대학교 정보통신융 신기능성 소재 및 공정연구센터 김용성

Pulsed laser deposition (PLD)법에 의하여 비대칭 적층주기를 갖는 BaTiO<sub>3</sub>/SrTiO<sub>3</sub> 인공격자를 (La,Sr)CoO<sub>3</sub> 산화물 전극이 코팅된 MgO(100) 단결정 기판위에 증착시켰다. 인공격자를 구성하고 있는 BTO와 STO의 두층중에 한 층의 두께를 2 unit cell로 유지시키고 다른 한층의 적층 두께를 변화시켰다. 즉 BTO/STO 인공격자의 비대칭적인 적층 주기는 BTO<sub>2 unit cell</sub>/STO<sub>32 unit cell</sub>에서 BTO<sub>32 unit cell</sub>/STO<sub>2 unit cell</sub>의 범위에서 이루어졌다. BTO/STO 인공격자의 전체 두께는 100 nm으로 고정되었다. 비대칭적인 적층주기를 갖는 BTO/STO 인공격자에서 BTO의 적층두께가 2unit cell로 고정된 STO 층과 함께 증가함에 따라 STO층의 격자변형은 상대적으로 두꺼운 BTO층으로부터 기계적인 변형으로 인해 증가되었다. 이러한 고정된 적층주기를 갖는 STO의 격자변형 (c/a)은 BTO<sub>32 unit cell</sub>/STO<sub>2 unit cell</sub>의 비대칭적인 적층 주기에서 1.10에 도달하였다. 반면에 BTO층의 격자 변형은 상대적으로 변화하지 않았다. 이와는 반대로 고정된 BTO층과 다양한 적층 두께를 갖는 STO층을 갖는 다층구조에서 상대적으로 얇은 적층 두께를 갖는 BTO층의 격자 변형이 가장 큰 격자변형을 보였다. 이와같이 비대칭적인 적층주기를 BTO/STO 인공격자의 유전율과 비선형성은 적층두께비가 변화되었다. 이것은 BTO/STO 인공격자의 다양한 비대칭적인 적층주기에서 BTO 또는 STO층의 심각한 격자변형에 기인되었다. BTO/STO 인공격자의 유전율은 BTO<sub>2 unit cell</sub>/STO<sub>2 unit cell</sub>의 적층주기에서 최대 1230으로 나왔고 비선형성은 94%으로 매우 높게 나왔다.